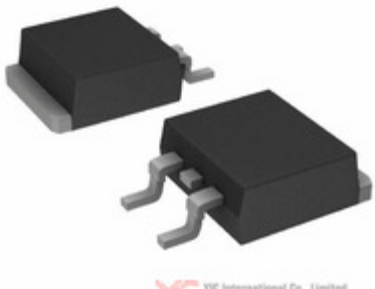








	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB80N06S3-07</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB80N06S3-07.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5500 pcs Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IPB80N06S3-07
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 80µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 mOhm @ 51A, 10V
Verlustleistung (max)	135W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7768pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	170nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB80N06S3-07 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB80N06S3-07-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB80N06S3-07 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPB80N06S3-07 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB80N06S3L-08</b> INFINEON IPB80N06S3L-08 INFINEON</p>	 <p><b>IPB80N06S3L-06</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO-263</p>	 <p><b>IPB80N06S3L-05</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO-263</p>	 <p><b>IPB80N06S3-07(3N0607)</b> INFINEON INFINEON TO-262</p>
 <p><b>IPB80N06S2L11ATMA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p>	 <p><b>IPB80N06S4-05</b> INF IPB80N06S4-05 INF</p>	 <p><b>IPB80N06S2L11ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p>	 <p><b>IPB80N06S3-05</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A TO263-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB80N06S3-07 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB80N06S3-07 Datenblatt	IPB80N06S3-07-Datenblätter	IPB80N06S3-07 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB80N06S3-07
IPB80N06S3-07 Electronic	IPB80N06S3-07-Komponenten	IPB80N06S3-07-Verteiler	IPB80N06S3-07-Bild	IPB80N06S3-07-Teil
IPB80N06S3-07 Preis	IPB80N06S3-07 Hersteller	IPB80N06S3-07 Bild	IPB80N06S3-07 Aktie	IPB80N06S3-07 Inventar
IPB80N06S3-07 Neu	IPB80N06S3-07 Original	IPB80N06S3-07 garantiert	IPB80N06S3-07 RFQ	IPB80N06S3-07 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited